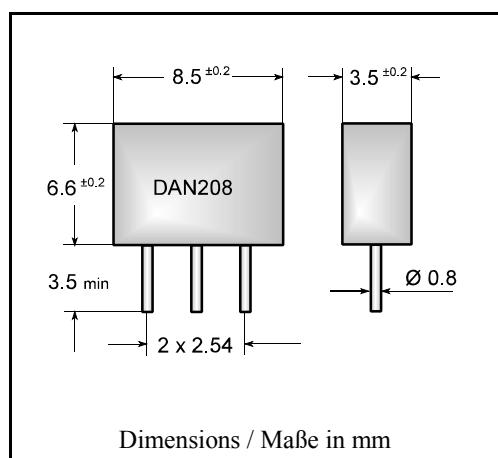
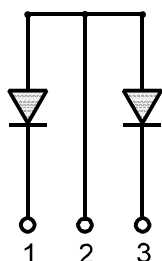


Silicon-Twin Diodes Center tap

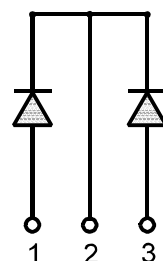
Silizium-Doppeldioden Mittelpunktschaltung



Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung	1.2 W
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	150 V
3 Pin-Plastic case 3 Pin-Kunststoffgehäuse	8.5 x 3.5 x 6.6 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton	



"DAP": common anodes / gemeinsame Anoden



"DAN": common cathodes / gemeinsame Kathoden

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
DAN 208	100	150
DAP 208	100	150

Max. average forward rectified current, R-load,
for one diode operation only
for simultaneous operation

$T_A = 25^\circ\text{C}$

I_{FAV}	1.0 A ¹⁾
I_{FAV}	2.0 A ¹⁾

Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last,
für eine einzelne Diode
bei gleichzeitigem Betrieb

$T_U = 25^\circ\text{C}$

I_{FAV}	1.0 A ¹⁾
I_{FAV}	2.0 A ¹⁾

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwell

$T_A = 25^\circ\text{C}$

I_{FSM}	10 A
-----------	------

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur

T_j – 50...+150°C
 T_s – 50...+150°C

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1\text{ A}$	V_F	$< 1.2\text{ V}^{1)}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 100\text{ V}$	I_R	$< 10\text{ }\mu\text{A}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	$< 45\text{ K/W}^{2)}$

¹⁾ Valid for one diode – Gültig für eine Diode

²⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten